

| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">SI5975DC-T1-GE3</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: SI5975DC-T1-GE3 |
| | Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET |
| | Datenblätter:  SI5975DC-T1-GE3.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI5975DC-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 450mV @ 1mA (Min) |
| Supplier Device-Gehäuse | 1206-8 ChipFET™ |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 86 mOhm @ 3.1A, 4.5V |
| Leistung - max | 1.1W |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SMD, Flat Lead |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 9nC @ 4.5V |
| Typ FET | 2 P-Channel (Dual) |
| FET-Merkmal | Logic Level Gate |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 12V |
| detaillierte Beschreibung | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 12V 3.1A 1.1W Surface |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 3.1A |

SI5975DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5975DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5975DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5975DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI5948DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V CHIPFET</p> |  <p>SI5975DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET</p> |  <p>SI5980DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 2.5A CHIPFET</p> |  <p>SI5975DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET</p> |
|  <p>SI5975DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET</p> |  <p>SI5975DC-T1 SOT23-8 SI5975DC-T1 SOT23-8</p> |  <p>SI5997DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 6A PPAK CHIPFET</p> |  <p>SI5999EDU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 6A POWERPAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| SI5975DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay | SI5975DC-T1-GE3 Datenblatt | SI5975DC-T1-GE3-Datenblätter | SI5975DC-T1-GE3 PDF | Electro-Films (EFI) / Vishay SI5975DC-T1-GE3 |
| SI5975DC-T1-GE3 Electronic | SI5975DC-T1-GE3-Komponenten | SI5975DC-T1-GE3-Verteiler | SI5975DC-T1-GE3-Bild | SI5975DC-T1-GE3-Teil |
| SI5975DC-T1-GE3 Preis | SI5975DC-T1-GE3 Hersteller | SI5975DC-T1-GE3 Bild | SI5975DC-T1-GE3 Aktie | SI5975DC-T1-GE3 Inventar |
| SI5975DC-T1-GE3 Neu | SI5975DC-T1-GE3 Original | SI5975DC-T1-GE3 garantiert | SI5975DC-T1-GE3 RFQ | SI5975DC-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited